

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 5 月 26 日 (26.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/048421 A1

- (51) 国際特許分類: H01S 5/022
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016768
(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 11 日 (11.11.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2003-384628
2003 年 11 月 14 日 (14.11.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三洋電機株式会社 (SANYO ELECTRIC CO., LTD) [JP/JP]; 〒5708677 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 Osaka (JP). 鳥取三洋電機株式会社 (TOTTORI SANYO ELECTRIC CO., LTD) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取市立川町 7 丁目 1 0 1 番地 Tottori (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本多 正治

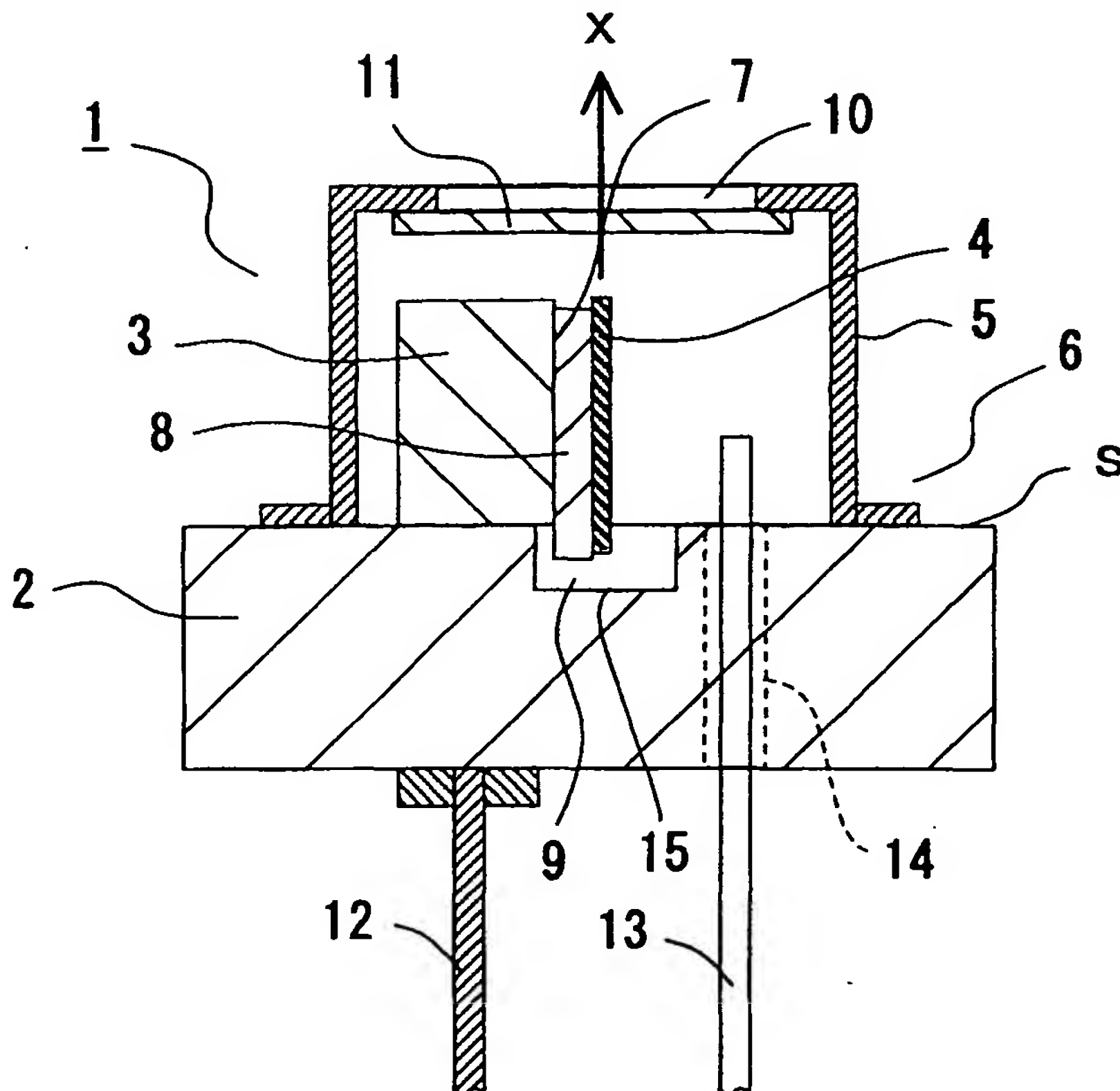
(HONDA, Shoji) [JP/JP]; 〒6808634 鳥取県鳥取市立川町 7 丁目 1 0 1 番地 鳥取三洋電機株式会社内 Tottori (JP).

- (74) 代理人: 井上 温, 外 (INOUE, Atsushi et al); 〒5400032 大阪府大阪市中央区天満橋京町 2-6 天満橋八千代ビル別館 5 階 Osaka (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR LASER APPARATUS

(54) 発明の名称: 半導体レーザ装置



(57) Abstract: A semiconductor laser apparatus, comprising a base part (2) having a horizontal upper surface (S), a heat sink part (3) having a vertical element arrangement surface (7) and positioned on the upper side of the upper surface (S) of the base part (2), and a semiconductor laser element (4) fixed to the element arrangement surface (7). A recess (9) is formed in the base part (2) at a position just below the semiconductor laser element (4), and a part of the semiconductor laser element (4) is disposed in the recess (9). The element arrangement surface (7) is positioned inward from the inner surface of the recess (9).

(57) 要約: 本発明の半導体レーザ装置は、水平方向の上面 (S) を備えるベース部 (2) と、垂直方向の素子配置面 (7) を有するとともにベース部 (2) の上面 (S) よりも上方に位置するヒートシンク部 (3) と、素子配置面 (7) に固定される半導体レーザ素子 (4) とを備え、半導体レーザ素子 (4) の直下に位置するベース部 (2) に窪み (9) を設け、この窪み (9) に半導体レーザ素子 (4) の一部を配置した。素子配置面 (7) は、窪み (9) の内側面よりも内方向に位置している。

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/048421 A1



KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書